




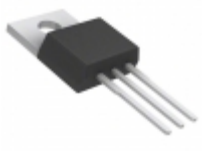



	<h2 style="color: red;">FDP040N06</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP040N06</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 120A TO220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP040N06.pdf 2.FDP040N06.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32412 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP040N06
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 120A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32412 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 120A (Tc) 231W (Tc) Through Hole
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	231W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	133nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8235pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP040N06 ist neu im Original, Suche FDP040N06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP040N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP040N06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP039N08B FSC FDP039N08B FSC</p>	 <p>FDP045N10A-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A TO-220-3</p>	 <p>FDP039N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 80V 120A TO-220</p>	 <p>FDP040N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO220</p>
 <p>FDP045N10A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A TO-220-3</p>	 <p>FDP038AN06A0-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO220-3</p>	 <p>FDP038AN06A0 FSC FDP038AN06A0 FSC</p>	 <p>FDP039N08B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 80V 120A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FDP020N06B	➔ FDP023N08B	➔ FDP025N06	D FDP025N06	➔ FDP027N08B
⊕ FDP027N08B	⊕ FDP030N06	D FDP030N06	➔ FDP030N06B_F102	➔ FDP032N08
⊕ FDP032N08	⊕ FDP032N08B	⊕ FDP036N10A	➔ FDP036N10A	➔ FDP038AN06A0
D FDP038AN06A0	⊕ FDP038AN06AO	⊕ FDP039N08B	⊕ FDP040N06	➔ FDP045N10A
➔ FDP045N10A	➔ FDP047AN08	⊕ FDP047AN08A0	⊕ FDP047AN08A0	➔ FDP047AN08AO
➔ FDP047N08	➔ FDP047N08	D FDP047N08AO	⊕ FDP047N10	⊕ FDP047N10
⊕ FDP050AN06A0	D FDP050AN06A0	➔ FDP050AN06AO	➔ FDP053N08B	➔ FDP053N08B_F102
⊕ FDP054N10	⊕ FDP054N10	➔ FDP060AN08A0	➔ FDP060AN08A0	➔ FDP060AN08AO
⊕ FDP060N08A0	⊕ FDP060N08AO	⊕ FDP068AN08A0	D FDP070AN06A0	➔ FDP070AN06AO
➔ FDP070AN06AO	⊕ FDP075N15A	⊕ FDP075N15A	⊕ FDP083N15A	➔ FDP083N15A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited